

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和3年7月8日(2021.7.8)

【公開番号】特開2021-82832(P2021-82832A)

【公開日】令和3年5月27日(2021.5.27)

【年通号数】公開・登録公報2021-024

【出願番号】特願2021-22508(P2021-22508)

【国際特許分類】

H 01 L	29/786	(2006.01)
H 01 L	21/8234	(2006.01)
H 01 L	27/088	(2006.01)
H 01 L	27/1156	(2017.01)
H 01 L	21/8242	(2006.01)
H 01 L	27/108	(2006.01)
H 01 L	21/8239	(2006.01)
H 01 L	27/105	(2006.01)

【F I】

H 01 L	29/78	6 1 8 E
H 01 L	29/78	6 1 8 B
H 01 L	27/088	E
H 01 L	27/088	3 3 1 E
H 01 L	27/1156	
H 01 L	27/108	3 2 1
H 01 L	27/108	6 7 1 Z
H 01 L	27/105	4 4 1

【手続補正書】

【提出日】令和3年4月26日(2021.4.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上方の半導体層と、

前記半導体層上方の窒化物絶縁層と、

前記窒化物絶縁層上方の第1の酸化物絶縁層と、

前記第1の酸化物絶縁層上方の金属酸化物層と、

前記金属酸化物層上方の第1の導電層、および第2の導電層と、

前記金属酸化物層、前記第1の導電層、および前記第2の導電層上方の第2の酸化物絶縁層と、

前記第2の酸化物絶縁層を介して前記金属酸化物層と重なる領域を有する第3の導電層と、を有し、

前記金属酸化物層は、前記第1の導電層及び前記第2の導電層と重畠しない領域に、前記第1の導電層及び前記第2の導電層と重畠する領域よりも膜厚が薄い領域を有し、

前記金属酸化物層は、第1の領域と、前記第1の領域上方の第2の領域と、を有し、

前記第1の領域、および前記第2の領域は少なくともインジウムを含み、

前記第1の領域は結晶構造を有する、半導体装置。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記半導体層は、多結晶シリコンを含む、半導体装置。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、

前記半導体層の少なくとも一部は、トランジスタのチャネル形成領域として機能する、半導体装置。